

MG1275S-BA1MM




Features

- Ultra Low Loss
- High Ruggedness
- High Short Circuit Capability
- Positive Temperature Coefficient
- With Fast Free-Wheeling Diodes

Applications

- Inverter
- Converter
- Welder
- SMPS and UPS
- Induction Heating

Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER
	E71639

Module Characteristics ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
R_{thJC}	Junction-to-Case Thermal Resistance	Per IGBT			0.2	K/W
R_{thJD}		Per Inverse Diode			0.5	K/W
Torque	Module-to-Sink	Recommended (M6)	3		5	N-m
Torque	Module Electrodes	Recommended (M5)	2.5		5	N-m
Weight				150		g

Absolute Maximum Ratings ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Values	Unit
IGBT				
V_{CES}	Collector - Emitter Voltage		1200	V
V_{GES}	Gate - Emitter Voltage		± 20	V
I_c	DC Collector Current	$T_c=25^\circ\text{C}$	105	A
		$T_c=80^\circ\text{C}$	75	A
I_{cpuls}	Pulsed Collector Current	$T_c=25^\circ\text{C}, t_p=1\text{ms}$	210	A
		$T_c=80^\circ\text{C}, t_p=1\text{ms}$	150	
P_{tot}	Power Dissipation Per IGBT		630	W
T_J	Junction Temperature Range		-40 to +150	$^\circ\text{C}$
T_{STG}	Storage Temperature Range		-40 to +125	$^\circ\text{C}$
V_{isol}	Insulation Test Voltage	AC, $t=1\text{min}$	3000	V
Diode				
V_{RRM}	Repetitive Reverse Voltage		1200	V
$I_{F(AV)}$	Average Forward Current	$T_c=25^\circ\text{C}$	90	A
		$T_c=80^\circ\text{C}$	60	A
$I_{F(RMS)}$	RMS Forward Current		90	A
I_{FSM}	Non-Repetitive Surge Forward Current	$T_J=45^\circ\text{C}, t=10\text{ms}, \text{Sine}$	430	A
		$T_J=45^\circ\text{C}, t=8.3\text{ms}, \text{Sine}$	450	

Life Support Note:

Not Intended for Use in Life Support or Life Saving Applications

The products shown herein are not designed for use in life sustaining or life saving applications unless otherwise expressly indicated.

MG1275S-BA1MM

Electrical and Thermal Specifications ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit	
IGBT							
$V_{GE(th)}$	Gate - Emitter Threshold Voltage	$V_{CE}=V_{GE}, I_C=3\text{mA}$	5.0	6.2	7.0	V	
$V_{CE(sat)}$	Collector - Emitter Saturation Voltage	$I_C=75\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		1.8		V	
		$I_C=75\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		2.0		V	
I_{CES}	Collector Leakage Current	$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		0.2	0.5	mA	
		$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		2		mA	
I_{GES}	Gate Leakage Current	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=\pm 20\text{V}$	-100		100	nA	
Q_{ge}	Gate Charge	$V_{CC}=600\text{V}, I_C=75\text{A}, V_{GE}=\pm 15\text{V}$		780		nC	
C_{ies}	Input Capacitance	$V_{CE}=25\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$		5.52		nF	
C_{oes}	Output Capacitance			0.4			
C_{res}	Reverse Transfer Capacitance			0.26			
$t_{d(on)}$	Turn - on Delay Time	$V_{CC}=600\text{V}$ $I_C=75\text{A}$ $R_G=15\Omega$ $V_{GE}=\pm 15\text{V}$ Inductive Load	$T_J=25^\circ\text{C}$		150		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		160		ns
t_r	Rise Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		65		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		65		ns
$t_{d(off)}$	Turn - off Delay Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		440		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		500		ns
t_f	Fall Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		55		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		70		ns
E_{on}	Turn - on Energy		$T_J=25^\circ\text{C}$		7.45		mJ
			$T_J=125^\circ\text{C}$		10.3		mJ
E_{off}	Turn - off Energy	$T_J=25^\circ\text{C}$		4.9		mJ	
		$T_J=125^\circ\text{C}$		7.8		mJ	
Diode							
V_F	Forward Voltage	$I_F=75\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		2.0	2.48	V	
		$I_F=75\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		1.7	2.2	V	
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F=75\text{A}, V_R=800\text{V}$ $di_F/dt=-1000\text{A}/\mu\text{s}$ $T_J=125^\circ\text{C}$		200		ns	
I_{RRM}	Max. Reverse Recovery Current			70		A	
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge			8.2		μC	

Figure 1: Typical Output Characteristics

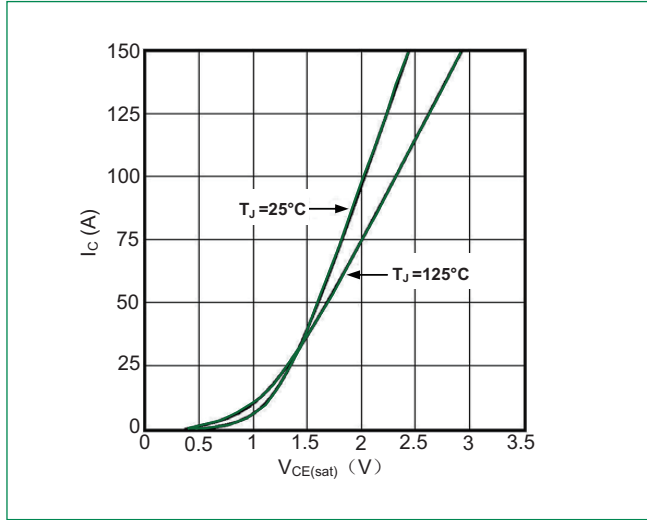


Figure 2: Typical Transfer characteristics

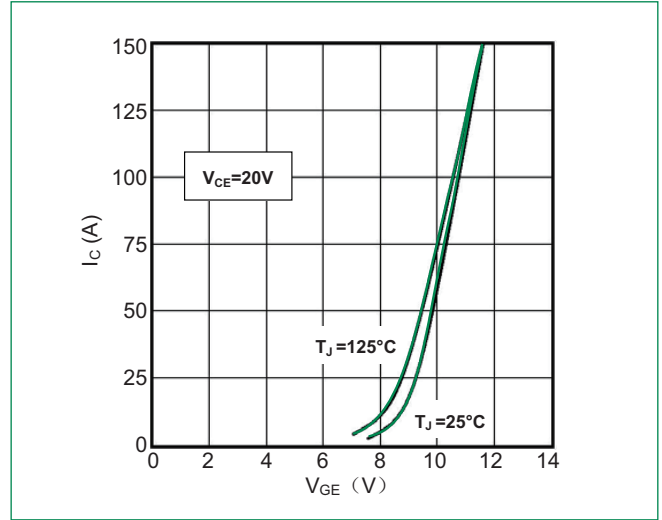


Figure 3: Switching Energy vs. Collector Current

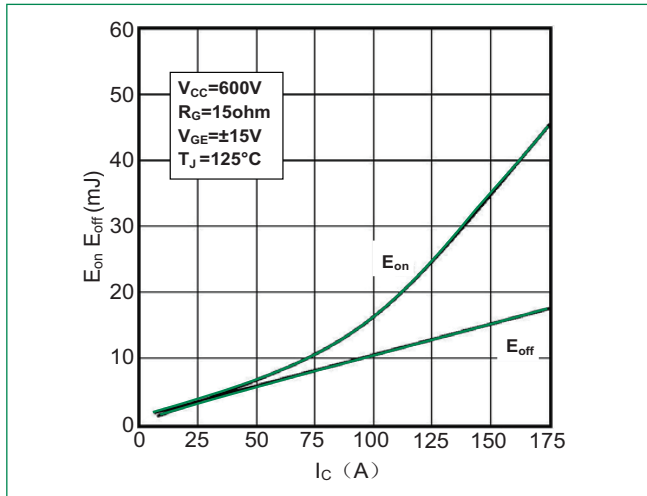


Figure 4: Switching Energy vs. Gate Resistor

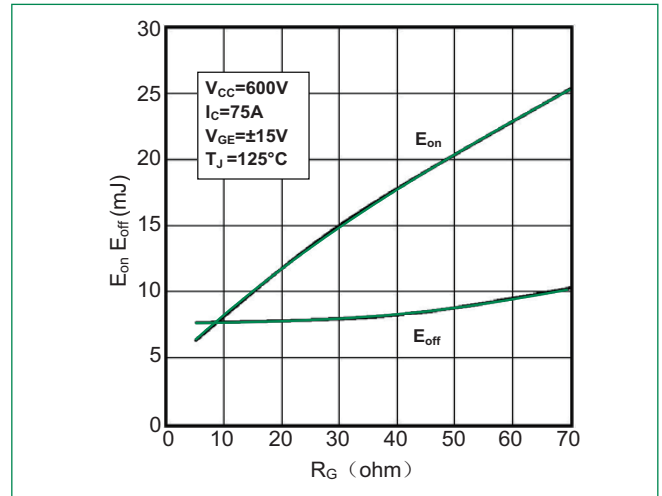


Figure 5: Switching Times vs. Collector Current

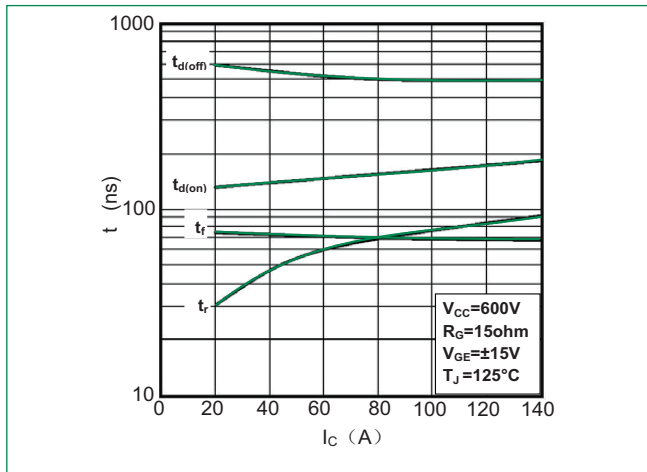


Figure 6: Switching Times vs. Gate Resistor

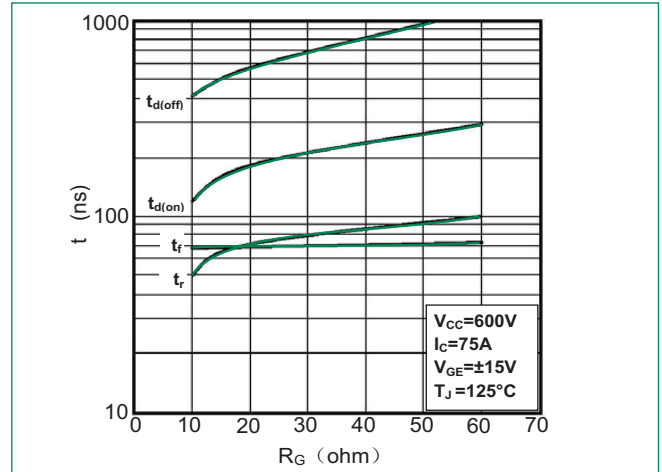


Figure 7: Gate Charge characteristics

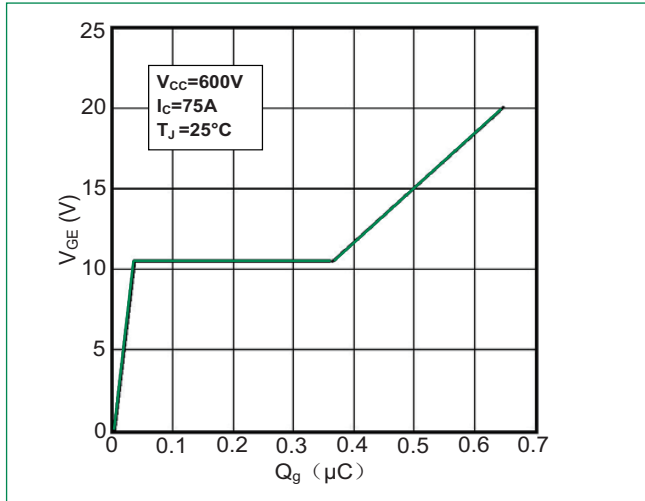


Figure 8: Typical Capacitances vs. V_{CE}

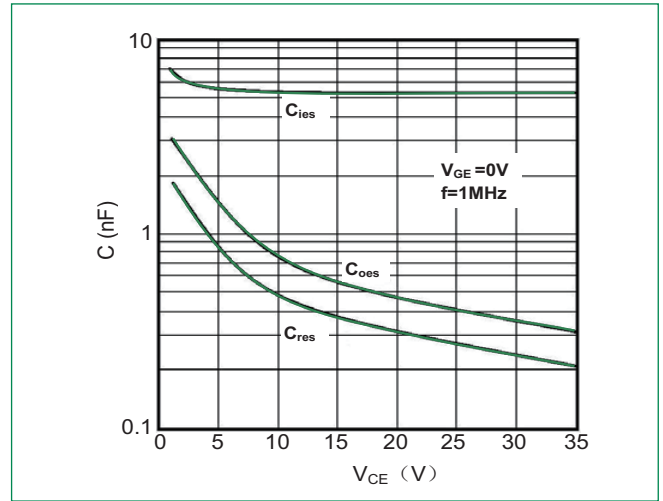


Figure 9: Reverse Biased Safe Operating Area

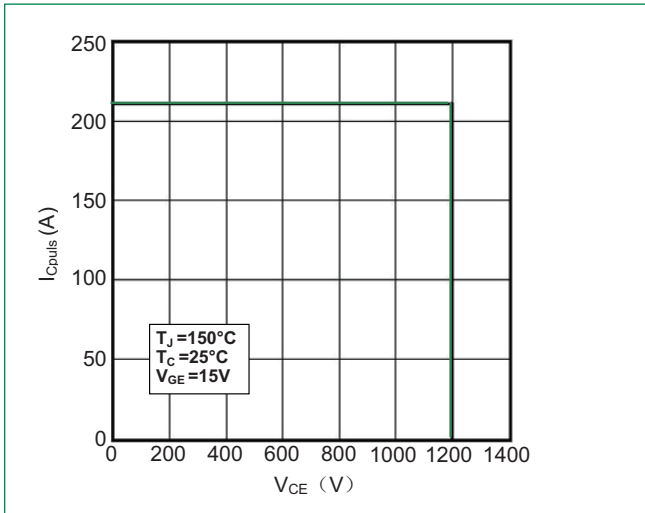


Figure 10: Short Circuit Safe Operating Area

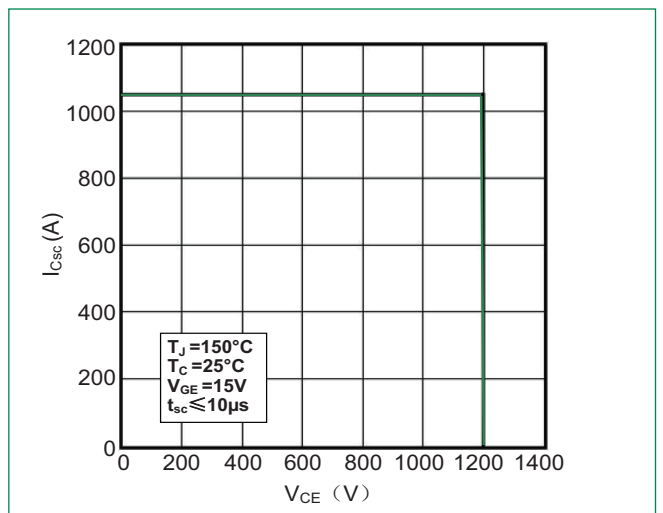


Figure 11: Rated Current vs. T_C

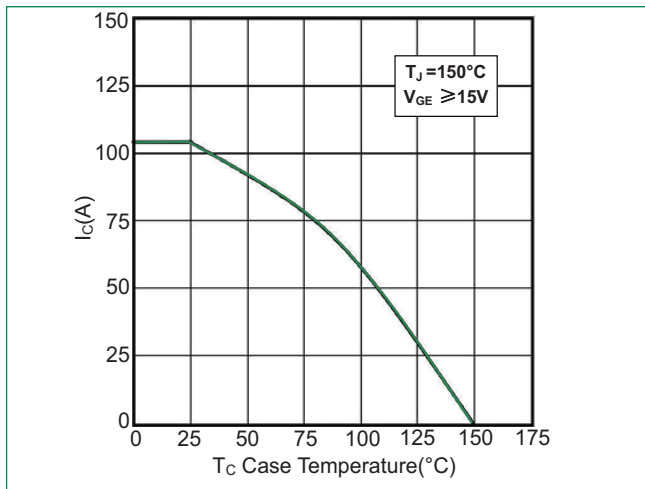


Figure 12: Diode Forward Characteristics

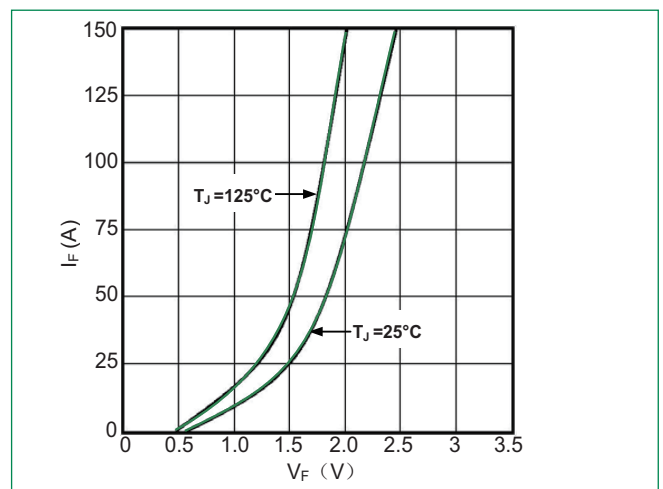


Figure 13: Transient Thermal Impedance of IGBT

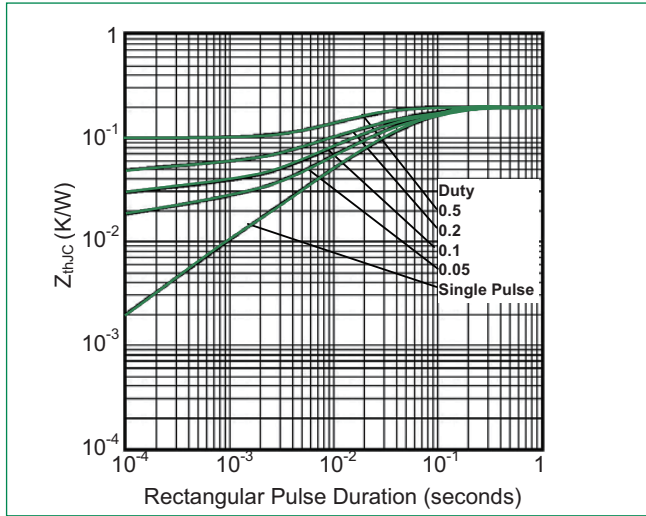
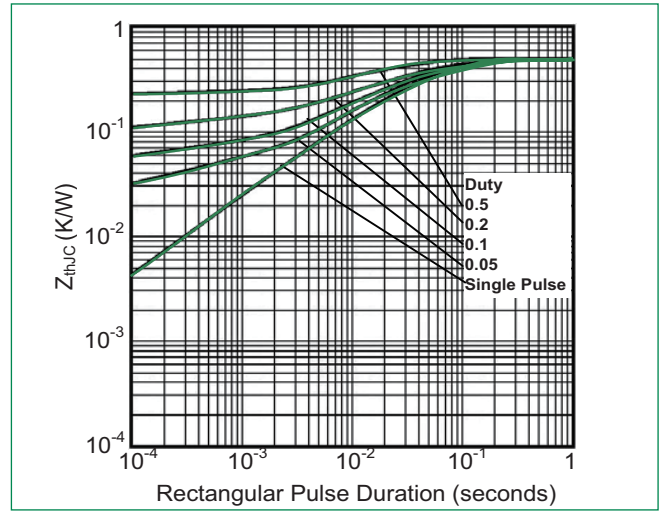
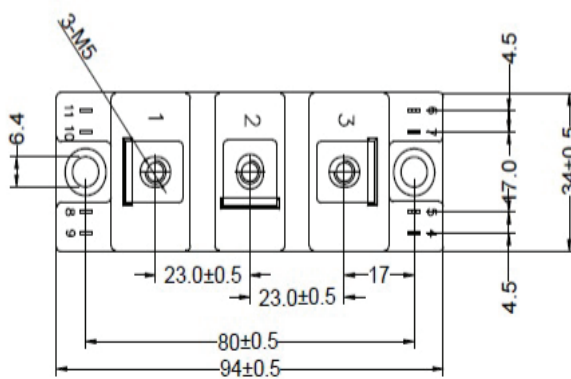
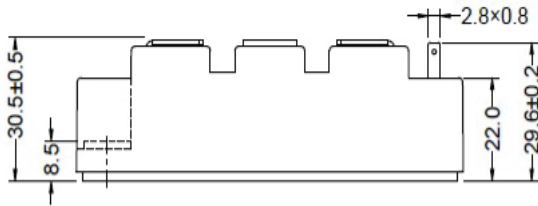


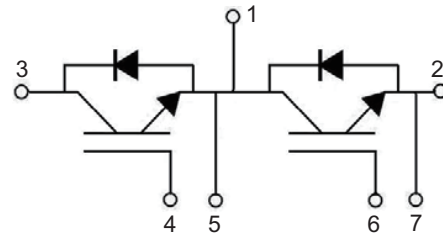
Figure 14: Transient Thermal Impedance of Diode



Dimensions-Package S



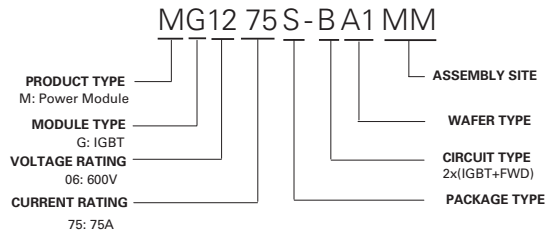
Circuit Diagram



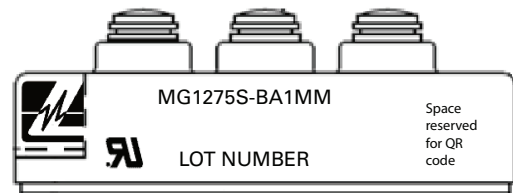
Packing Options

Part Number	Marking	Weight	Packing Mode	M.O.Q
MG1275S-BA1MM	MG1275S-BA1MM	150g	Bulk Pack	100

Part Numbering System



Part Marking System



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А